

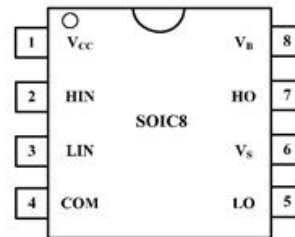
概述

PN7106A/B 是一款基于 P 衬底、P 外延的高压、高功率 MOSFET 和 IGBT 半桥驱动芯片。其浮地通道能工作在 600V 的高压下，可用于驱动 2 个 N 型功率 MOSFET 或 IGBT 构成的半桥结构（版本 B），或者其他高低侧结构（版本 A）。该芯片逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。输出具有大电流脉冲能力。传输延时具有匹配性，以简化在高频下的应用。

特征

- 高压范围达+600 V
- 3.3 V 逻辑兼容
- 抗 dV/dt 能力 $\pm 50 \text{ V/nsec}$
- 自举工作的浮地通道
- 栅驱动电压范围 10V~20V
- 高低侧通道均具有欠压保护（UVLO）功能
- 输出拉灌电流能力 400 mA / 900mA
- 独立的逻辑输出以适应所有的拓扑结构（A 版本）
- 100ns 固定死区时间，以进行防穿通保护（B 版本）
- 抗-5V 瞬态负 V_s 能力
- 高低侧通道均延时匹配

封装/订购信息



Part number	Order Code	Package
PN7106A	PN7106ASEC-R1	SOIC8
PN7106B	PN7106BSEC-R1	SOIC8

应用领域

- 中小型功率电机驱动
- 功率 MOSFET 或 IGBT 驱动
- 照明镇流器
- 半桥功率逆变器
- 全桥功率逆变器
- 任何互补型的驱动逆变器（非对称的半桥，有源钳位）（版本 A）

典型应用

